

SOT23 NPN硅平面

高压晶体管

第3期 - 1995年11月

7

FMMT6517

特点

* 350伏V
15, 在我增益 $\beta_c=100\text{mA}$

应用

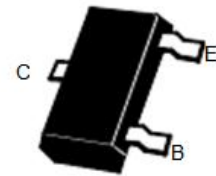
*适用于放大器和交换产品

互补式 -

FMMT6520

PARTMARKING详细信息 -

517



SOT23

绝对最大额定值。

参数	符号	价值	单位
集电极 - 基极电压	V_{CBO}	350	V
集电极 - 发射极电压	V_{CE}	350	V
发射极 - 基极电压	V_{EBO}	5	V
连续集电极电流	I_C	500	mA
在T功耗 $A_{MB} = 25^\circ\text{C}$	$P_{合计}$	330	mW
工作和存储温度范围	$T_j, T_{存储}$	-55到+150	$^\circ\text{C}$

电气特性 (在T

$A_{MB} = 25^\circ\text{C}$ 除非另有说明)。

参数	符号	分钟。	马克斯。	单位	条件。
击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	350		V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
	$V_{(BR)CEO}$	350		V	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$
	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$
截止电流	I_{CBO}		50	nA	$V_{CB}=250\text{V}, I_E=0$
	I_{EBO}		50	nA	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$
集电极 - 发射极饱和电压	$V_{CE(SAT)}$		0.3	V	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}^*$
			0.35	V	$I_C=20\text{mA}, I_B=2\text{mA}^*$
			0.5	V	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}^*$
			1.0	V	$I_C=50\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$
基射饱和电压	$V_{BE(SAT)}$		0.80	V	$I_C=10\text{mA}, I_E=1\text{mA}^*$
			0.85	V	$I_C=20\text{mA}, I_E=2\text{mA}^*$
			0.90	V	$I_C=30\text{mA}, I_E=3\text{mA}^*$
基射极导通电压	$V_{BE(ON)}$		2.0	V	$I_C=100\text{mA}, I_E=10\text{V}^*$
静态正向电流传输比	h_{FE}	20			$I_C=1\text{mA}, I_E=10\text{V}$
		30			$I_C=10\text{mA}, I_E=10\text{V}^*$
		30	200		$I_C=30\text{mA}, I_E=10\text{V}^*$
		20	200		$I_C=50\text{mA}, I_E=10\text{V}^*$
		15			$I_C=100\text{mA}, I_E=10\text{V}^*$
输出电容	$C_{输出}$		6	pF	$V_{CB}=20\text{V}, F=1\text{MHz}$ 的
跃迁频率	f_T	50		兆赫	$I_C=10\text{mA}, I_E=20\text{V}, F=20\text{MHz}$ 的

*脉冲条件下进行测定。脉冲宽度 = 300

$\mu\text{秒}$ 。占空比 = 2%